

2SB753

シリコンPNP三重拡散形(PCT方式)

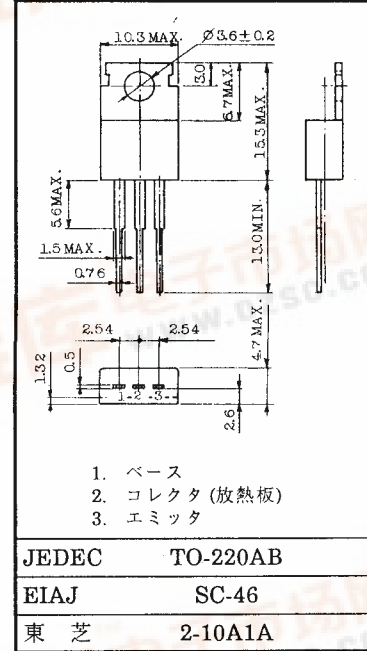
- 大電流フットプリント用
- 電力増幅用

通信工業用
単位: mm

- ・ 許容コレクタ電流が大きい。: $I_C = -7A$
- ・ コレクタ飽和電圧が低い。
: $V_{CE(sat)} = -0.5V$ (最大) ($I_C = -4A$)
- ・ 許容コレクタ損失が大きい。: $P_C = 40W$ ($T_c = 25^\circ C$)
- ・ 2SD843とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-7	A
ベース電流	I_B	-1	A
コレクタ損失	P_C	$T_a = 25^\circ C$	1.5
		$T_c = 25^\circ C$	40
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	—	—	-5	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-5	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -50mA, I_B = 0$	-80	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -1V, I_C = -1A$	70	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -4A$	30	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -4A, I_B = -0.4A$	—	-0.3	-0.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -4A, I_B = -0.4A$	—	-0.9	-1.4	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -4V, I_C = -1A$	—	10	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	250	—	pF
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	—	0.4	—	μs
	蓄積時間	t_{stg}	—	2.5	—	
	下降時間	t_f	—	0.5	—	

測定回路図: 入力 I_{B2} , 出力, $20\mu s$, I_{B1} , I_{B2} , $V_{CC} = -30V$, $-I_{B1} = I_{B2} = 0.3A$, 繰り返し周期 $\leq 1\%$

注: $h_{FE(1)}$ 分類 O: 70~140, Y: 120~240